

三星全新 microSD 卡以高效能、大容量 開啟行動運算與智慧終端 AI 新紀元

三星推出業界首款 256GB 大容量 SD Express microSD 卡樣品，運作速度超越現行介面四倍以上

三星 1TB UHS-1 microSD 卡採用最新 V-NAND 技術，現已進入量產階段

此為全球發布中譯新聞稿，實際產品上市資訊依各市場公告版本為準

全球先進記憶體技術領導品牌三星電子宣佈已啟動測試 256GB^(註一) SD Express^(註二) microSD 卡，其連續讀取速度高達每秒 800 MB，而 1TB^(註三) UHS-1 microSD 卡亦進入量產。隨著新一代 microSD 卡陣容亮相，三星展現為未來行動運算與智慧終端 AI 應用所需記憶體提供最佳解決方案的企圖心。

三星電子記憶體品牌產品業務團隊副總裁 Hangu Sohn 表示：「三星以兩款全新 microSD 卡，為行動運算和智慧終端 AI 與日俱增的記憶體需求，打造有效率的解決方案。儘管尺寸極小，新款記憶卡強大效能與超大容量近似 SSD 固態硬碟，幫助用戶最大化現今與未來行動裝置的運作效能。」



業界首款 SD Express microSD 卡，最高讀取速度可達 800 MB/s

三星在 SD Express 介面上導入全新高效能的 microSD 卡，該項業界創舉源自三星與客戶合作開發客製產品的成功經驗。

三星 SD Express microSD 卡採用低功耗設計並優化韌體技術，具備絕佳的性能與溫度管理，尺

寸雖小，卻擁有與固態硬碟相當的效能表現。採用 UHS-1 介面的傳統 microSD 卡讀取速度最高僅 104 MB/s，SD Express 則可將速度提升到 985 MB/s；然而，將此項技術導入 microSD 的商業化運用直到現今才出現。

三星 SD Express microSD 卡的連續讀取速度高達 800 MB/s - 是 SATA SSD 固態硬碟（最高 560 MB/s）的 1.4 倍，同時也較傳統 UHS-1 記憶卡（最高 200 MB/s）快四倍以上，能提升各種設備 - 如個人電腦和行動裝置的運算效能。為確保小尺寸規格的效能穩定性，其採用三星的動態散熱保護（DTG）技術，即使長時間運作，亦能將 SD Express microSD 卡維持在最佳溫度。



1TB UHS-1 microSD 卡採用最新型 1Tb V-NAND

三星新款 1TB microSD 卡，將八層三星第八代 1Tb V-NAND 堆疊在小尺寸 microSD 卡內，如此規模的大容量記憶體封裝，過去技術只能實現於固態硬碟中。三星新款 1TB microSD 卡通過業界最嚴謹的測試，具有防水、耐極端溫度、防摔設計、防磨損保護、防 X 光和防磁功能^(註四)，即便在嚴苛環境也能穩定使用。

產品上市資訊

256GB SD Express microSD 卡將於本年度上市，1TB UHS-1 microSD 卡預計在今年第三季推出。

註一：1 吉位元組 (GB) = 1,000,000,000 位元組 (10 億位元組)。實際可用容量可能會有所不同。

註二：SD Express：新款採用 PCIe Gen3x1 介面（根據 2019 年 2 月公布的 SD 7.1 規範）的 SD 卡，傳輸速度理論值為 985 MB/s。

註三：1 兆位元組 (TB) = 1,000,000,000,000 bytes (1 萬億位元組)。實際可用容量可能會有所不同。

註四：對於任何因記憶卡救援而產生的數據損壞和資料遺失及其相關費用，三星不承擔法律責任。所聲稱的六種防護功能只適用於 1TB UHS-1 microSD 卡，不適用於 256GB SD Express microSD 卡。1 公尺深度，鹽水，72 小時。作業溫度 -25°C 至 85°C (-13°F 至 185°F)，非作業溫度 -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F)。能承受標準機場 X 光機（最高 100mGy）。磁場等同於高磁場磁共振造影儀（最高 15,000 高斯）。可承受最高 5 公尺（16.4 英尺）的掉落衝擊。最多 10,000 次摩擦。